

©1995 г.

## ЭФФЕКТ СЕГРЕГАЦИИ РТУТИ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ОТЖИГЕ $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$

*М.Кузьма, М.Поцяск, Е.Шерегий, В.Кемпник, М.Фарина, Р.Цях*

Институт физики Высшей педагогической школы,  
35-310 Жешув, Польша

(Получена 4 февраля 1994 г. Принята к печати 13 декабря 1994 г.)

Получено непосредственное экспериментальное подтверждение образования резкого максимума концентрации ртути на малой (0.2 мкм) глубине от облучаемой поверхности под воздействием многократного импульсного отжига кристаллов  $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$  ( $x = 0.2$ ) излучением лазера YAG : Nd<sup>3+</sup>.

Механизм структурных превращений в твердых растворах теллуридов кадмия и ртути при воздействии лазерного излучения продолжает активно обсуждаться в печати [1–5]. Современные методы анализа позволяют непосредственно получить реальное количественное распределение компонент в материале, подвергнутом лазерной обработке. Такое исследование проведено в работе [1] с помощью электронной поверхностной оже-спектроскопии для кристаллов с  $x = 0.2$ –0.22, облученных наносекундными импульсами лазера YAG : Nd малой мощности, равной 0.14 Дж/см<sup>2</sup>. Обнаружено незначительное изменение распределения состава по глубине в пределе до 15 нм с несколько неоднозначными данными. Более определенные результаты получены в работе [2] в аналогичном эксперименте. Однако здесь длина импульса была значительно больше ( $t = 100$  нс) и в 2 раза больше плотность энергии. Показано, что структурные превращения происходят на глубине, не превышающей 0.2 мкм. Обнаружены максимумы концентрации ртути и теллура в этом пределе. Следует отметить, что этот результат в большей степени связан с рекристаллизацией при лазерной обработке, приводящей к оплавлению поверхности.

Данные как работы [2], так и более ранней работы [3] согласуются в некоторой степени с эффектом сегрегации ртути, предсказанным компьютерным симулированием процессов диффузии при лазерном отжиге в предыдущей нашей работе [6]. Напомним, что этот эффект обусловлен присутствием максимума градиента температуры, а его интенсивность зависит от величины пространственного объема, охватываемого этим градиентом. В этом отношении предпочтение должно

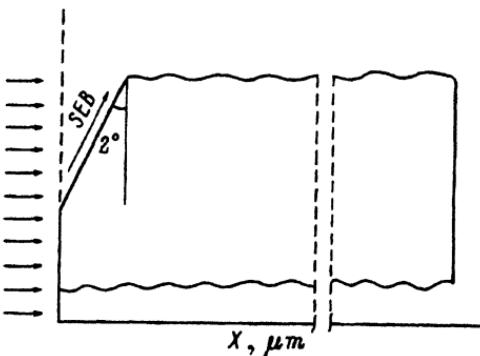


Рис. 1. Схема измерения концентрации компонент твердого раствора с помощью рентгеновского микроанализа. Стрелкой показано направление сканирующего электронного луча.

быть отдано более длительным импульсам. При этом концентрационный максимум усиливается при их повторении и нет необходимости в фазовых превращениях, так как самодостаточным оказывается сам процесс диффузии, точнее термодиффузии [7,8], обусловленной так называемым «фононным ветром» [9,10].

Данная работа посвящена экспериментальной проверке этого главного вывода работы [6]. Облучению лазера YAG:Nd<sup>3+</sup> ( $\lambda = 1.06 \text{ мкм}$ ) с длительностью импульса  $t = 250 \text{ мкс}$  были подвергнуты несколько объемных образцов Cd<sub>0.2</sub>Hg<sub>0.8</sub>Te, вырезанных из одной и той же шайбы. Предварительные размеры образцов составляли  $4 \times 1 \times 0.5 \text{ mm}^3$ . После механической обработки нарушенный слой был снят 0.5%-м раствором бром-метанола. Гальваномагнитные измерения показали идентичные характеристики образцов: концентрация электронов  $n = (1.5 \div 2) \times 10^{15} \text{ см}^{-3}$  и подвижность электронов  $\mu_e \approx 9 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ . Достаточная мощность лазера позволяла расфокусировать луч и создавать при этом энергетически однородное световое пятно. Измеренная при этом плотность энергии была около  $0.8 \text{ Дж}/\text{см}^2$ . Облучение образцов не приводило к визуальным изменениям их поверхности. Часть из них была подвергнута обработке однократными, другая — трехкратными импульсами.

Поскольку предполагалось измерить распределение профиля концентрации компонент по глубине с помощью рентгеновского микроанализа, имеющего, как известно, наилучшее разрешение порядка 1 мкм, для увеличения пространственного разрешения было решено микроанализ состава проводить вдоль поверхности клина, пересекающего под малым углом ( $2^\circ$ ) исследуемый профиль (рис. 1). Это позволило улучшить разрешение в  $(\sin 2^\circ)^{-1} = 29$  раз. Поверхность клина была протравлена 0.05%-м раствором бром-метанола.

Приготовленные таким образом образцы были разделены на две партии с тремя образцами в каждой:

- 1) образцы без лазерной обработки (тоже с клином);
- 2) образцы после обработки однократным лазерным импульсом;
- 3) образцы после трехкратной лазерной обработки.

Первая партия образцов была отправлена для количественного рентгеновского микроанализа в Краковскую региональную лабораторию физико-химического анализа и структурных исследований (Польша). Измерения проводились с помощью спектрометра IXA-50A JOEL сканированием электронного луча вдоль поверхности клина. Результаты этих исследований представлены на рис. 2.

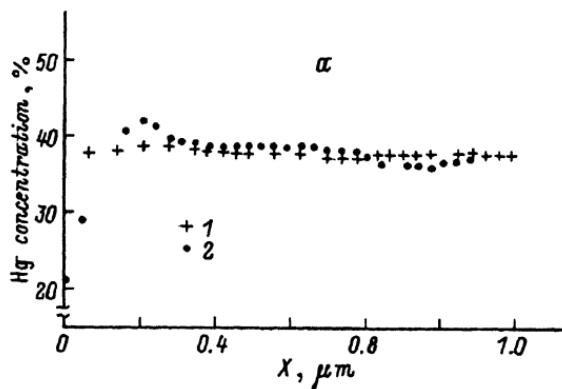


Рис. 2. Экспериментальное распределение концентрации ртути перед обработкой (1) и после трехкратной обработки (2) лазером YAG:Nd<sup>3+</sup> ( $\lambda = 1.06$  мкм,  $t_p = 250$  мкс) с плотностью энергии 0.8 Дж/см<sup>2</sup>.

Вторая партия образцов была отправлена для измерений распределения компонент в Институт материалов АН Украины (Львов). Здесь измерения проводились с помощью сканирующего рентгеновского микроанализатора СОМЕВАХ. Результаты этих измерений представлены на рис. 3.

На рис. 2 показано количественное распределение концентрации ртути после обработки трехкратным лазерным импульсом. Для сравнения приведена подробная зависимость для необлученного образца. Видно существенное изменение концентрационного профиля ртути в образце после трехкратного импульса (после однократного импульса однозначных изменений не наблюдалось). На глубине около 0.2 мкм образовался достаточно резкий максимум концентрации Hg. Значительный ее спад у самой поверхности достигает глубины около 23%. Для сравнения на рис. 4 приведено расчетное пространственно-временное распределение концентрации Hg на основе термодиффузационной модели [6] в предположении, что начальная концентрация межузельных атомов ртути составляет  $N_0 = 10^{15}$  см<sup>-3</sup>. Видно хорошее качественное совпадение теоретического и экспериментального распределения. Наиболее существенное количественное расхождение состоит в том, что теоретическое положение концентрационного максимума ртути находится в области 1 мкм от облучаемой поверхности, в то время как на экспериментальной кривой — в области 0.2 мкм.

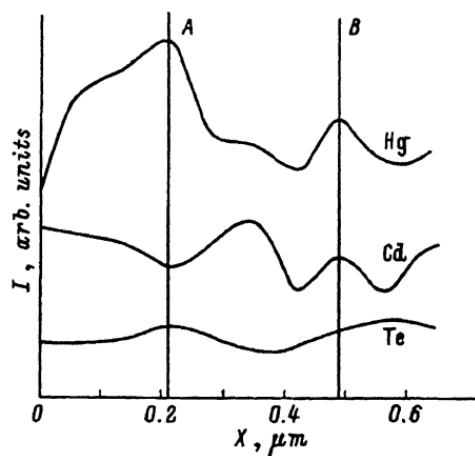


Рис. 3. Экспериментальный профиль концентрации компонент Cd, Hg, Te по глубине образца после воздействия трех лазерных импульсов (параметры те же, что и на рис. 2).

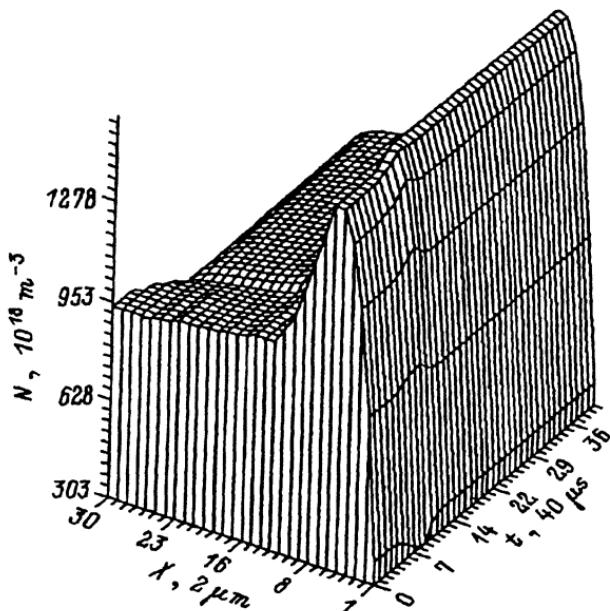


Рис. 4. Теоретическое распределение концентрации ртути  $N$  после трехкратной лазерной обработки. Параметры импульса  $t_p = 250$  мкс, плотность выделяемой мощности излучения  $W = 3.08 \cdot 10^{13}$  Вт/м<sup>3</sup>, что соответствует плотности энергии 0.8 Дж/см<sup>2</sup>, коэффициент поглощения  $\alpha = 10^{-6}$  м<sup>-1</sup>, начальная концентрация  $N_0 = 10^{21}$  см<sup>-3</sup>.

Как уже отмечалось, результаты независимых параллельных исследований концентрационных профилей представлены на рис. 3. Здесь показаны распределения всех трех компонент материала. Следует отметить полное качественное и в значительной мере количественное согласие концентрационных кривых ртути на рис. 2 и 3. Видно даже, что в плоскости A (глубина 0.2 мкм на рис. 3) максимуму концентрации ртути соответствует минимум концентрации кадмия и некоторое повышение концентрации теллура. В то же время в плоскости B (глубина около 0.5 мкм) имеем очередной максимум концентрации ртути. На этот раз ему соответствует также незначительный максимум концентрации кадмия при понижении концентрации теллура. Подобная ситуация наблюдалась в работе [2].

Таким образом, два независимых параллельных измерения концентрационных профилей компонент Cd<sub>0.2</sub>Hg<sub>0.8</sub>Te после отжига трехкратным лазерным импульсом (без расплавления поверхности) подтвердили предсказанный термодиффузионной теорией [6] эффект сегрегации ртути (резкий максимум ее концентрации). Отметим, что однократного импульса длительностью 250 мкс недостаточно для того, чтобы этот максимум стал экспериментально заметным. Можно предположить, что при более кратких импульсах даже их многократное повторение не приведет к заметным изменениям концентрационных профилей, т.е. средств термодиффузии (без фазовых превращений) недостаточно для образования экспериментально заметного сегрегационного максимума ртути при наносекундных импульсах.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Напомним, что в работе [2] лазерная обработка наносекундными импульсами проводилась в режиме рекристаллизации.

## Список литературы

- [1] C.N. Afonso, M. Alonso, J.L.H. Neira et al. *J. Vac. Sci. Technol.*, **A7**, 3256 (1989).
- [2] П.В. Голошинин, К.Е. Миронов, А.Я. Поляков. *Поверхность. Физика, химия, механика*, № 12, 12 (1991).
- [3] Г.Г. Громов, С.В. Серегин, С.В. Жук, В.Б. Уфимцев. *Физика и химия обраб. материалов*, № 4, 19 (1990).
- [4] M. Kuźma, C. Abeynayake, E. Sheregii, I. Virt. *Acta Phys. Polon. A*, **8C**, 475 (1991).
- [5] И.С. Вирт, М. Кузьма, Е.М. Шерегий, П.С. Шкумбатюк. *ФТП*, **26**, 562 (1992).
- [6] А. Валь, М. Кузьма, М. Поцяск, Е.М. Шерегий. *ФТП*, **27**, 622 (1993).
- [7] G. Schottky. *Phys. St. Sol. (b)*, **8**, 357 (1965).
- [8] M. Wautelet, P. Quenon, C. Antoniadis, L.D. Laude. *Semicond. Sci. Technol.*, **2**, 453 (1987).
- [9] В.И. Фикс. *Ионная проводимость в металлах и полупроводниках* (М., Наука, 1969).
- [10] В.П. Воронков, Г.А. Гурченок. *ФТП*, **24**, 1831 (1990).

Редактор Т.А. Полянская

### Effect of mercure segregation in $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ under laser pulse annealing

*M.Kuźma, M.Pociask, E.Sheregii, V.Kęmpnick, M.Farina, R.Ciach*

Institute for Physics, High Pedagogical School, 35-310 Rzeszów, Poland

---